PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-318155

(43) Date of publication of application: 16.11.2001

(51)Int.Cl.

G01T 1/20 A61B 6/03

G01T 7/00

(21)Application number : 2001-051443

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

27.02.2001

(72)Inventor: MIYAGI TAKESHI

FUKAZAWA YOSHIKAZU

ONO MACHIKO
IKEDA MITSUSHI

(30)Priority

Priority number : 2000052383

Priority date: 28.02.2000

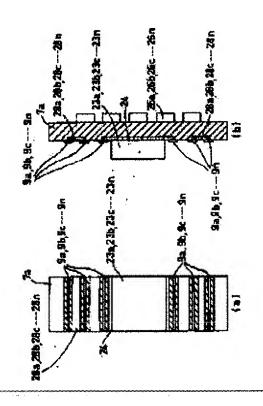
Priority country: JP

(54) RADIATION DETECTOR AND X-RAY CT DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation detector which can take a photograph of high resolution in a shorter photography time and a CT device which uses it.

SOLUTION: At least photodiode arrays 4, 24, 34, and 44 or switching elements 8a to 8n, 28a to 28n, 38a to 38n, and 48a to 48n and wiring boards 7, 7a, 7b, and 7c or the photodiode arrays and switching elements are electrically connected through flexible substrates 9a to 9n, 39, or bumps 49a to 49n.



[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公園番号 特開2001 —318155 (P2001 —318155A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

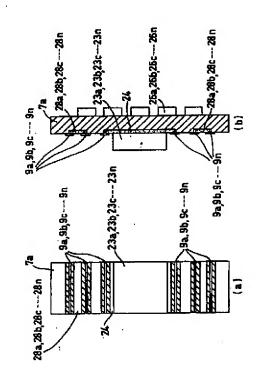
(51) Int.Cl.7		設別記号	FΙ			テーマコード(参考)
G01T	1/20		G01T	1/20	G	2G088
					E	4 C 0 9 3
A61B	6/03	3 2 0	A 6 1 B	6/03	3 2 0 S	
G01T	7/00		G01T	7/00	Α	
			審查請求	未請求	請求項の数5	OL (全 8 頁)
(21)出願番号		特膜 2001-51443(P2001-51443)	(71)出顧人	000003078 株式会社東芝		
(22)出闢日		平成13年2月27日(2001.2.27)			*************************************	番1号
(DE) MAN H		1 March 2 1 2 1 2 1 M Construction,	(72)発明者			
(31)優先権主張番号		特願2000-52383 (P2000-52383)		神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株		
(32)優先日		平成12年2月28日(2000.2.28)		式会社》	*芝生産技術セン	ター内
(33)優先權主張国		日本 (JP)	(72)発明者	深澤 身	美和	
				栃木県フ	大田原市下石上字	東山1385番の1
				株式会社	土東芝那須工場内	
			(74)代理人	1000831	.61	
				弁理士	外川 英明	

(54) 【発明の名称】 放射線検出器、およびX線CT装置

(57)【要約】

【課題】 撮影時間を短縮し、かつ、高解像度な撮影の可能な放射線検出器とそれを用いたC T装置を提供する こと。

【解決手段】 フォトダイオードアレイ4,24,3 4,44又はスイッチング素子8a~8n,28a~2 8n,38a~38n,48a~48nと、配線基板 7,7a,7b,7cとの接続、あるいは、前記フォト ダイオードアレイと前記スイッチング素子との接続のう ち、少なくともいずれかの接続が、フレキシブル基板9 a~9n、39、又は、バンプ49a~49nを介して 電気的に接続される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 配線基板の一方の面に、シンチレータ部 材と光学的に接続されたフォトダイオードアレイとこの フォトダイオードアレイと電気的に接続されたスイッチ 素子とが実装され、前記配線基板の他方の面に、前記フ ォトダイオードアレイからの電気信号を受けるデータ収 集素子が実装された放射線検出器において、

1

前記フォトダイオードアレイもしくは前記スイッチング 素子と前記配線基板との接続、および、前記フォトダイ オードアレイと前記スイッチング素子との接続の少なく 10 ともいずれか一方の接続が、フレキシブル基板を用いて 電気的に接続されているととを特徴とする放射線検出 器.

【請求項2】 前記フレキシブル基板を用いての前記各 部位との電気的な接続は、異方性導電シートもしくはT ABにより接続されていることを特徴とする請求項1記 載の放射線検出器。

【請求項3】 配線基板の一方の面に、シンチレータ部 材と光電変換面とが光学的に接続されたフォトダイオー ドアレイと、このフォトダイオードアレイと電気的に接 20 続されたスイッチ素子が実装され、前記配線基板の他方 の面に前記フォトダイオードアレイからの電気信号を受 けるデータ収集素子が実装された放射線検出器におい て、

前記フォトダイオードアレイは、前記光電変換面が形成 されている主面から他方の主面に貫通する貫通配線が形 成されており、前記他方の主面上に設けられたバンプに より前記配線基板に対して実装されていることを特徴と する放射線検出器。

【請求項4】 前記貫通配線は、ポリシリコン、▼、N 30 i、Cuのいずれか一の材料により構成されていること を特徴とする請求項3記載の放射線検出器。

【請求項5】 請求項1乃至4項のいずれかに記載の放 射線検出器を具備することを特徴とするX線CT装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、放射線検出器とそ れを用いたマルチスライスのX線CT装置に関する。 [0002]

やマルチスライス方式の出現と、X線発生器と検出器の 高速回転化により、撮影時間の短縮、高精細な断層画像 を実現している。特に、撮影時間の短縮は検査時におけ る患者の苦痛を少なくできるため、今後さらなる高速化 が要望されている。また、同時に撮影画像の髙精細化が 進み、これまでのX線CTでは見ることのできなかった 腫瘍の発見や、静止状態と同等の臓器画像を撮影するこ とが可能となっている。X線CT装置としては、例え は、特開平10-127617号公報や、特開平10-73666号公報、特開平11-221207号公報な 50 ことを目的としている。

どに、その構成が開示されている。X線検出装置は、フ ォトダイオード等の光センサ(光電変換器)を有するX 線検出器モジュールが、被写体の体軸方向(スライス方 向) に沿って複数列形成された構造を基本としている。 すなわち、X線管球から曝射され被検体を透過した放射 線であるX線を、X線検出器モジュールに備えられたシ ンチレータにより吸収し、その吸収量に応じて発生され る蛍光を、光センサであるフォトダイオードによって電 気信号に変換して出力するようになっている。スイッチ 装置によるスイッチング動作により、フォトダイオード アレイからの信号出力を、増幅機能やA/D変換機能を 有するデータ収集装置に順次送る。

【0003】図7(a)は、従来の放射線検出器の構成 の一例を示す平面図で、図7(b)は、その側面断面図 である。すなわち、配線基板91は多層配線基板で形成 され表面に所定の配線パターン(不図示)が設けられて いる。この配線基板91の表面上にはフォトダイオード アレイ92とスイッチ素子93a、93b、93c…9 3nが実装され、フォトダイオードアレイ92とスイッ チング素子93a、93b、93c…93nとはボンデ ィングワイヤ94a、94b、94c…94nによって 接続されている。また、スイッチ素子93a、93b、 93c…93nはボンディングワイヤ94a、94b、 94 c…94 n によって配線基板91の配線パターンに 接続され、との配線バターンは基板配線95a、95 b、95c…95nを介して配線基板の裏面のコネクタ 96a、96b、96c…96nに接続されている。と のコネクタ96a、96b、96c…96nには、フラ ットケーブルなどの電線97a、97b、97c…97 nが取り付けられており、モジュール外部のデータ収集 装置(図示せず)と接続されて信号の送受信を行なう。 なお、フォトダイオードアレイ92の上部には、放射線 であるX線を可視光に変換するシンチレータ部材98 a、98b、98c…98nが搭載されている。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】X線検出器の構成で は、近時の医療現場から、さらなる撮影時間の短縮と高 解像度な撮影が要求されている。X線検出器の性能を向 上させるには、スライス数を増やすことが有効である 【従来の技術】X線CT装置は、ヘリカルスキャン方式 40 が、スライス数が多くなるとフォトダイオードアレイか ちの信号数が著しく多くなることから、フォトダイオー ドアレイやスイッチ素子、配線基板のボンディングパッ ドのビッチや面積が非常に小さくなり、ワイヤボンディ ング法では接続が不可能である。とのため、従来技術に おけるマルチスライスX線CTでは4スライスまでが限 界であり、新たな構造の放射線検出器の開発が望まれて いた。本発明はこれらの事情に基づいてなされたもの で、摄影時間を短縮し、かつ、高解像度な撮影の可能な 放射線検出器と、それを用いたX線CT装置を提供する

[0005]

【課題を解決するための手段】上記した課題を解決する ために本発明は、配線基板の一方の面に、シンチレータ 部材と光学的に接続されたフォトダイオードアレイとこ のフォトダイオードアレイと電気的に接続されたスイッ チ素子とが実装され、前記配線基板の他方の面に、前記 フォトダイオードアレイからの電気信号を受けるデータ 収集素子が実装された放射線検出器において、前記フォ トダイオードアレイもしくは前記スイッチング素子と前 記配線基板との接続、および、前記フォトダイオードア レイと前記スイッチング素子との接続の少なくともいず れか一方の接続が、フレキシブル基板を用いて電気的に 接続されている放射線検出器を提供する。とのとき、前 記フレキシブル基板を用いての前記各部位との電気的な 接続は、異方性導電シートもしくはTABにより接続さ れていることが好ましい。

【0006】また本発明は、配線基板の一方の面に、シ ンチレータ部材と光電変換面とが光学的に接続されたフ ォトダイオードアレイと、このフォトダイオードアレイ 線基板の他方の面に前記フォトダイオードアレイからの 電気信号を受けるデータ収集素子が実装された放射線検 出器において、前記フォトダイオードアレイは、前記光 電変換面が形成されている主面から他方の主面に貫通す る貫通配線が形成されており、前記他方の主面上に設け られたバンプにより前記配線基板に対して実装されてい る放射線検出器を提供する。

【0007】とのとき、前記貫通配線は、ボリシリコ ン、W、Ni、Cuのいずれか一の材料により構成され ていることが好ましい。

【0008】また本発明は、これらの放射線検出器を具 備するX線CT装置を提供する。

[0009]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の一実施の形態に ついて図面を参照しながら説明する。放射線検出器が集 積されて構成されるでX線固体検出装置の構成の一例 を、図1(a)および(b)にもとづいて説明する。図 1 (a) はX線固体検出装置の検出部の斜視図で、図1 (b) はそれの構成要素である放射線検出器の斜視図で ある。医用のCTスキャナ装置(不図示)は、放射線で あるX線源と被検体の体軸方向およびX線入射方向に対 して垂直な方向 (チャンネル方向) に1列に並ぶ複数の X線を検出するための放射線検出器モジュールla、l b、1c…1nとを架台と共に被検体の回りで回転移動 させることにより、X線ビームが被検体と交差する角度 を定常的に変化させながらスキャンしてデータを得てい る。放射線検出器モジュールla、lb、lc…ln は、チャンネル方向に1列に並んで複数列、すなわち、 8列以上で例えば10列が設けられ、X線源から放射さ

である投影データを検出している。

【0010】つまり、放射線検出器モジュール1a、1 b、1c…1nは、被検体を透過したX線線量を忠実に 電荷量に変換するもので、それに用いられている各シン チレータセグメント2a、2b、2c…2nを構成して いる各シンチレータ部材3a、3b、3c…3nがX線 を受けて蛍光を発し、フォトダイオード4 a 、4 b 、4 c…4nから構成されたフォトダイオードアレイ4によ って電荷量(電流)に変換している。このように、放射 10 線検出器モジュールは、シンチレータブロックが発する 可視光を光電変換するモジュールであることから、「シ ンチレータモジュール」とも呼ばれる。CTスキャナに 用いられるシンチレータ部材3a、3b、3c…3nの 材料としては、無機結晶で、Nal(T1)、Csl (T1) BGO (Bi4Ge3O14), CdWO4 等が用いられることが多い。

【0011】すなわち、放射線検出器に設けられた放射 線検出器モジュール(マルチスライス)1a、1b、1 c…lnは、X線を受光すると可視光を発光する2次元 と電気的に接続されたスイッチ素子が実装され、前記配 20 に配列された個別のシンチレータ部材3a、3b、3c …3nからなるシンチレータセグメント2a、2b、2 c…2nと、このシンチレータセグメントにおいて発光 した光を受光し信号電流を発生させるよう光学的に接合 されたフォトダイオード4a、4b、4c…4nと、シ ンチレータセグメントとフォトダイオードアレイとの間 に配置され、シンチレータ部材のチャンネルに沿った方 向の配列上の位置ずれを隠すライン状のX線遮蔽体で構 成する図示しないストライブブロックと、そしてこのX 線遮蔽体に垂直にX線源側に配置したコリメータ5と、 それらを一体に保持するための支持材6と、によって構 成される。

【0012】このような放射線検出器を構成するため に、まず、シンチレータ部材3a、3b、3c…3nを 位置決め接着して順次各シンチレータセグメント2a、 2b、2c…2nを形成し、これをフォトダイオードア レイ4の上に光学的に接着し、その後、配線基板7と電 気的に接続されるように固着することにより放射線検出 器モジュール1a、1b、1c…1nを構成する。そし て、シンチレータ部材のピッチにあわせるよう組み込ま 40 れたコバルト合金製のコリメータ5に対して、フォトダ イオードアレイ4を接着した放射線検出器モジュール l a、lb、lc…lnを位置合わせするようにして、支 持材6に固定している。支持材6は、コリメータ5が所 定ビッチに維持されるよう、各々を一体的に保持してい る。なお、配線基板7は多層配線基板であり、その表面 にも所定の配線パターンが設けられている。この配線基 板7の表面側にはフォトダイオードアレイ4とスイッチ 素子が実装され、フォトダイオードアレイ4とスイッチ 素子とは電気的に接続されている。また、このスイッチ れるX線ファンビーム (X線ビーム) のX線減衰測定値 50 素子は、配線基板7中に形成された貫通配線を介して、

配線基板7の裏面側に実装されているデータ収集素子 (後述する) に電気的に接続されている。

【0013】したがって、放射線検出器モジュール1 a、1b、1c…1nが有するシンチレータブロックに より受光した放射線は、その放射線量に応じた電力を有 する電気信号に光電変換される。各フォトダイオード素 子における電気信号を、スイッチ素子で素子選択しつつ 取り出すことにより、シンチレータブロックに入射した 放射線に対応する電気信号出力を検出データとして得る ことができる。この検出データを半導体集積回路からな 10 た、フレキシブル基板上や接続部分には、機械的強度と るデータ収集素子であるDAS(Data Acqui sition System)により収集処理し、外部 装置へ送出する。図2はDASの処理内容を示すブロッ ク図である。すなわち、X線がシンチレータブロックに より可視光に変換され光電変換された後の信号の処理順 序を示すものであり、シンチレータブロックを有する放 射線検出器モジュールla、lb、lc…lnからDA Sに検出データが送出され、順次アンプ11、サンブル ホールド12、マルチプレクサ13、A-D変換機14 において処理され、インターフェース15から、外部装 20 め、それへの対応は困難であった。 置であるコンピュータ16に対して出力を行う。次に、 配線基板に固定された放射線検出器モジュール、すなわ ち放射線検出器の各実施例について詳細に説明する。 【0014】(実施例1)図3(a)は本発明の放射線 検出器の平面図で、図3(b)はその断面側面図であ る。配線基板7aはセラミックスやガラスエポキシ材か らなり、多層配線で形成され表面に所定の配線パターン (不図示)が設けられている。この配線基板7a上には フォトダイオードアレイ24とスイッチ素子28a、2 8 b、28 c…28 n が実装され、フォトダイオードア レイ24やスイッチ素子28a、28b、28c…28 nが実装される部分は各素子24 および28 a、28 b、28c…28nの厚さに合わせて掘り込まれ、各素 子24および28a、28b、28c…28nの面と配 線基板7 aの面がほぼ同一の高さになるように構成され ている。フォトダイオードアレイ24上には、X線を光 に変換するシンチレータ部材23a、23b、23c… 23 nが光学的に接続されて実装されている。また、配 線基板7aの裏面にはデータ収集素子26a、26b、 26c…26nが実装されている。また、フォトダイオ 40 る。との実施例における放射線検出器の構造は、配線基 ードアレイ24と配線基板7aはパターン配線が施され たフレキシブル基板9a、9h、9c…9nでそれぞ れ、配線基板7 aの配線バターンに電気的に接続されて おり、また、スイッチ素子28a、28b、28c…2 8 n と配線基板 7 a の入出力と同様に、配線基板 7 a の 配線パターンにフレキシブル基板9a、9b、9c…9 nで接続されている。したがって、各素子24および2 8a、28b、28c…28nは配線基板7aの配線パ ターンを介してそれぞれ電気的に接続されている。

…9nと各素子2および28a、28b、28c…28 nの接続には、異方性導電シートを用いたACF(An isotropic Conductive Fil e) 法や、金バンブなどの突起状電極をあらかじめ形成 してボンディングを行なうTAB法を用いている。本実 施例では、ポリイミド材からなる絶縁シート上に、最小 配線幅が35ミクロン、配線間距離が15μm、配線ピ ッチが50μmの銅配線を形成したフレキシブル基板7 を、異方性導電シートを用いて接続を行っている。ま 絶縁性の向上のため、エポキシ系樹脂により保護コート を施している(図示せず)ために、スライス数が8列以 上(例えば10列)になっても正確に接続することがで きる。これに対して、従来行なわれていた方法であるワ イヤボンディング法の場合では、実用的には80μm程 度のバッドピッチへのボンディングが限界であったた め、スライス数が8列以上になると、フォトダイオード アレイの各素子から取り出す信号線の数が膨大になり、 50μ皿以下のパッドピッチへの接続が要求されるた

- 6

【0016】とれらの放射線検出器モジュールの製造方 法について、図3(a)と図3(b)を参照して説明す る。まず、厚膜配線技術と同時焼成技術を用いて製作さ れたセラミック多層配線基板である配線基板7aの裏面 に、パッケージングされたデータ収集素子26a、26 b、26c…26nを半田付けにより実装する。次い で、フォトダイオードアレイ24とスイッチ素子28 a、28b、28c…28nとを、エポキシ系樹脂を用 いて配線基板7aの表面に接着固定する。その後、フレ キシブル基板9a、9b、9c…9nと実装した各素子 24 および28 a、28 b、28 c…28 n と配線基板 7 a の位置合わせを行い、異方性導電シートにより接続 を行った。その際の異方性導電シートの硬化温度は18 0℃で行った。最後に、シンチレータ部材23a、23 b、23c…23nをフォトダイオードアレイ24に対 して位置合わせを行い接着することで、放射線検出器モ ジュールを形成した。

【0017】(実施例2)図4(a)は本発明の放射線 検出器の平面図で、図4(b)はその断面側面図であ 板の表面に実装された各素子間を電気的に接続している フレキシブル基板の形状以外は、(実施例1)の構造と 同様である。

【0018】すなわち、配線基板7bはセラミックスや ガラスエポキシ材からなり、多層配線で形成され表面に 所定の配線パターン (不図示) が設けられている。この 配線基板7b上にはフォトダイオードアレイ34とスイ ッチ素子38a、38b、38c…38nが実装され、 フォトダイオードアレイ34やスイッチ素子38a、3 【0015】 これらフレキシブル基板9a、9b、9c 50 8b、38c…38nが実装される部分は各素子の厚さ

に合わせて掘り込まれ、各素子34および38a、38 b、38c…38nの面と配線基板7の面がほぼ同一の 高さになるように構成されている。フォトダイオードア レイ34上には、X線を光に変換するシンチレータ部材 33a、33b、33c…33nが光学的に接続されて 実装されている。配線基板7bの裏面にはデータ収集素 子36a、36b、36c…36nが実装されている。 また、フォトダイオードアレイ34と配線基板7bは、 配線が施されたフレキシブル基板39で電気的に接続さ れており、また、スイッチ素子38a、38b、38c 10 トダイオードアレイ44とスイッチ素子48a、48 …38nと配線基板7bの入出力も同様にフレキシブル 基板79で接続されている。これらフレキシブル基板3 9と各素子34および38a、38b、38c…38n の接続には、異方性導電シートを用いたACF (Anisotr opic ConductiveFilm)法や、金バンプなどの突起状電 極をあらかじめ形成してボンディングを行なうTAB法 を用いている。

【0019】とのように、各素子34および38a、3 8 b 、 3 8 c … 3 8 n の電気的な接続のための回路を 1 枚のフレキシブル基板39上に形成したものであるた め、フレキシブル基板39の種類や枚数が減り、さらに 接続工程も減少させるととができるためにコスト的にも 有利である。ただし、この場合は、フレキシブル基板3 9の接続には、フォトダイオードアレイ34、配線基板 7b、スイッチ素子38a、38b、38c…38nの それぞれの電極と、フレキシブル基板39の電極とが正 確に位置合わせされた状態で各素子34および38a、 38b、38c…38nを配線基板7bに接着させる必 要がある。この位置合わせには、例えば、ハーフミラー (不図示)を有する両面位置合わせ装置(不図示)を用 30 いることにより実現可能である。

【0020】この実施例で示した放射線検出器モジュー ルの製造方法は、基本的には(実施例1)の製法と同様 である。まず、厚膜配線技術と同時焼成技術を用いて製 作されたセラミック多層配線基板である配線基板7bの 裏面に、バッケージングされたデータ収集素子36 a、 36b、36c…36nを半田付けにより実装する。次 いで、フォトダイオードアレイ34とスイッチ素子38 a、38b、38c…38nを、エポキシ系樹脂を用い て配線基板7bの表面に接着固定する。その後、フレキ 40 Cuのいずれかによって形成することができる。また、 シブル基板39と、実装した各素子34および38a、 38b、38c…38nと配線基板7bの位置合わせを 行い、異方性導電シートにより接続を行った。その際の 異方性導電シートの硬化温度は180℃で行った。最後 に、シンチレータ部材33a、33b、33c…33n をフオトダイオードアレイ34に対して位置合わせを行 った後に接着することで、放射線検出器モジュールを形 成した。

【0021】(実施例3)図5(a)は本発明の放射線 検出器の平面図で、図5(b)はその断面側面図であ

る。この実施例における放射線検出器の構造は、フォト ダイオードアレイやスイッチ素子など検出器を構成する 部品は(実施例1)および(実施例2)と同様である が、この実施例では、フォトダイオードアレイやスイッ チ素子がそれぞれバンブを用いて配線基板にフリップチ ップ実装されている。すなわち、配線基板7cはセラミ ックスやガラスエポキシ材からなり、多層配線基板で形 成され表面に所定の配線パターン(不図示)が設けられ ている。との配線基板7c上の配線パターン上にはフォ b、48c…48nが、バンプ49a、49b、49c …49nを介して実装されている。フォトダイオードア レイ44上には、X線を光に変換するシンチレータ部材 43a、43b、43c…43nが配置されている。ま た、配線基板7cの裏面側にはデータ収集素子48a、 48b、48c…48nが、パンプ49a、49b、4 9 c…49 nを介して実装されている。

【0022】との実施例で示した放射線検出器の製造方 法は、まず、厚膜配線技術と同時焼成技術を用いて製作 20 されたセラミック多層配線基板である配線基板7 cの裏 面に、バッケージングされたデータ収集素子46a、4 6b、46c…46nを、また、セラミック多層配線基 板71の表面にスイッチ素子48a、48b、48c… 48 nを半田付けにより実装する。この場合、スイッチ 素子48a、48b、48c…48nとデータ収集素子 46a、46b、46c…46nは、各チップのおもて 面に形成された電極に、バンブ49a、49b、49c …49nを例えば電気メッキ法により形成し、フリップ チップ法により実装している。

【0023】図6に、本発明のフォトダイオードアレイ 44の断面の模式図を示す。光電変換部の本体となるフ ォトダイオード44a、44b、44c…44nが形成 されている各々の拡散層51から信号を取り出す配線5 2が、フォトダイオードアレイ44の表面に形成されて いる。との配線52は、Si配線基板53の表裏を貫通 して形成された貫通配線54に接続されるように延設さ れている。フォトダイオード44の裏面側には、貫通配 線54に接続された状態でバンプ55が形成されてい る。なお、貫通配線54は、ポリシリコン、W、Ni、 各配線52、54とSi配線基板53の間は、シリコン 酸化膜で絶縁膜56a、56b、56cを形成して絶縁 されている。貫通配線54の貫通穴はRIE方式のドラ イエッチングにより容易に形成でき、導電材料の充填は CVD法や電気めっき法により行なうことが可能であ る。充填材料は、CVD法ではボリシリコンやタングス テン、電気めっき法ではニッケルや銅が、電気的特性の 面から有効である。また、突起状電極は電気めっき法に より形成した銅バンプや半田バンブが高い信頼性で配線 50 基板7と接続することができる。

10

【0024】通常、フォトダイオードアレイは、光電変換面と同じ側の主面に、光電変換によって得られた電流を出力するための電極が形成されている。このようなフォトダイオードアレイにおいては、原理的に光の検出を行なうためのフォトダイオード本体が形成されている面を多層配線基板側に向けて実装することは許されないため、従来は、ワイヤボンディングによって配線パターンとの接続が行われていた。本実施例では、図6に示す構造とすることにより、フォトダイオードアレイのフリップチップ実装を可能とした。

【0025】以上に説明したように、スライス数の多い放射線検出器の実装構造には、フォトダイオードアレイと配線基板、あるいは、フォトダイオードアレイとスイッチ素子、あるいは、スイッチ素子と配線基板の少なくとも一つの組み合わせが、フレキシブル基板7を異方性導電シート(ACF法)もしくはTAB法で電気的に接続する構造が有効である。また、光電変換部が配列された表面から裏面にむけて、内部を貫通する貫通配線54を設け、この貫通配線54に接続されるよう、バンブ55を裏面に形成したフォトダイオードアレイを構成した。バンプを用いて配線基板7にフリップチップ実装した構造は、光電変換面の高密度化に寄与し、さらにスライス数の多い放射線検出器の実装構造に適している。【0026】また、これらの放射線検出器を、図1

[0027]

【発明の効果】本発明によれば、従来技術では、高い信米

(a) に示したように円弧状に配列して構成したX線C

T装置は有用である。それにより、放射線源から出たX

線が人体を透過した後に放射線検出器に吸収され、その

透過データをコンピュータで処理することで、精密で良

好な画像が得ることが実現可能となる。

* 頼性を持たせ、かつ、低いコストが実現できなかったマルチスライスX線CTで使用する放射線検出器を実現可能とする。また、それを用いたX線CT装置は、精密で良好な画像を得ることを可能とする。

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a)はX線固体検出装置の斜視図、(b) は放射線検出器の斜視図。

【図2】 DASにおける信号処理の経路を示すブロック図。

10 【図3】 (a) は本発明の放射線検出器の実施例の平面図、(b) はその断面側面図。

[図4] (a)は本発明の放射線検出器の実施例の平面図、(b)はその断面側面図。

【図5】 (a)は本発明の放射線検出器の実施例の平面図、(b)はその断面側面図。

【図6】 本発明のフォトダイオードアレイの実施形態 を示す断面側面図。

[図7] (a)は従来の放射線検出器の実施例の平面図、(b)はその断面側面図。

20 【符号の説明】

la, lb, lc~ln…放射線検出器モジュール、

2a, 2b, 2c~2n…シンチレータセグメント、

3a, 3b, 3c~3n…シンチレータ部材、

4, 24, 34, 44…フォトダイオードアレイ、

7, 7a, 7b, 7c…配線基板、

8a~8n, 28a~28n, 38a~38n, 48a ~48n…スイッチ素子、

9a, 9b, 9c~9n, 39…フレキシブル基板、

26a~26n, 36a~36n, 46a~46n…デ

30 ータ収集素子、

49a, 49b, 49c~49n…バンプ

[図1]

1a, 1b, 1c --- 1n

4a, 4b, 4c --- 4a

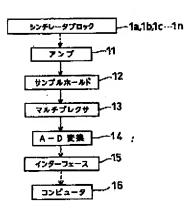
3a, 3b, 3c --- 3n

2a, 2b, 2c --- 2n

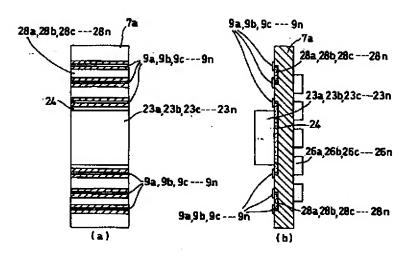
1a, 1b, 1c --- 1n

(b)

【図2】

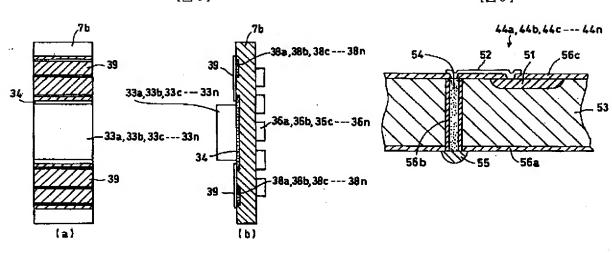


【図3】

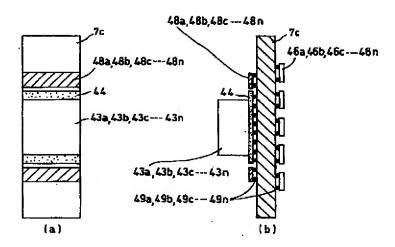


【図4】

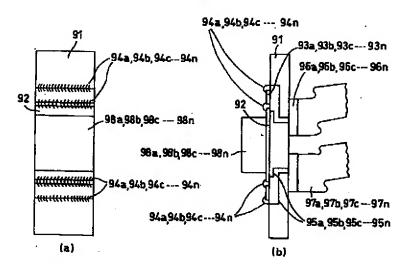




【図5】



【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 小野 真知子

栃木県大田原市下石上字東山1385番の1 株式会社東芝那須工場内 (72)発明者 池田 光志

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝研究開発センター内

Fターム(参考) 2G088 EE02 FF02 GG19 JJ02 JJ05

))33

4C093 AA22 BA10 CA02 CA18 CA27

EB12